

СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ МНСТ

- Галиев Г. Б., Буряков А. М., Билык В. Р., Хусяинов Д. И., Мишина Е. Д., Климов Е. А., Ключков А. Н., Пушкарев С. С., Васильевский И. С., Грехов М. М., Трунькин И. Н., Васильев А. Л. Терагерцевое излучение эпитаксиальных низкотемпературных GaAs структур на подложках GaAs (100) и (111)A 515
- Алёшин А. Н. Изучение деформационного поля в слоях метаморфного ступенчатого буфера на основе тройных растворов $\text{In}_x\text{Al}_{1-x}\text{As}$ методом построения карт обратного пространства 526
- Павлов А. Ю. Переход от сплавной к несплавной технологии омических контактов при росте диапазона рабочих частот СВЧ МИС на основе нитрида галлия 541

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МНСТ

- Дашков А. В., Щаврук Н. В., Щеглова Т. А., Тарасов Н. С., Мальцев П. П., Хабибуллин Р. А. Апробация способа изготовления контейнеров из антистатического материала для полупроводниковых кристаллов сложной формы на основе 3D-печати 551

ЭЛЕМЕНТЫ МНСТ

- Белкин М. Е., Ключник Д. А., Фофанов Д. А. Характеристики электрооптического преобразования современных лазерных излучателей при распределении по оптическому волокну опорных радиосигналов дециметрового диапазона 556
- Матвеев О. С. Интегрированные антенны для использования в системах на кристалле 568

Аннотации и статьи на русском и английском языках доступны на сайте журнала (<http://microsystems.ru>; <http://novtex.ru/nmst/>) в разделе "Архив статей с 1999 г."

ПОДПИСКА:

по каталогу Роспечати (индекс 79493);
по каталогу "Пресса России" (индекс 27849)
в редакции журнала (тел./факс: (499) 269-55-10)

Адрес для переписки:

107076 Москва,
Стромынский пер., д. 4
e-mail: nmst@novtex.ru

Учредитель:

Издательство "Новые технологии"